

2DK12 型硅肖特基开关整流二极管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 B2-01B 型金属封装，典型重量 8.9g。
器件具有正向压降小、开关速度快、可靠性高的特点。器件的静电放电敏感度为 3A 级 4000V。



B2-01B 型

2、质量等级及执行标准

G、G+级，QJ/01RBJ010H1，QZJ840611；
JP、JT、JCT 级，QJ/01RBJ019-99，GJB33A-1997；
YA、YB、YC：Q/QJA 20104/35-2017，Q/QJA 20104A-2017。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	I_{FM}^{a} $T_{\text{C}}=75^{\circ}\text{C}$ (A)	V_{BR} (V)	V_{RWM} (V)	I_{FSM} (A)	T_{j} ($^{\circ}\text{C}$)	T_{stg} ($^{\circ}\text{C}$)
2DK12A	3（双芯）	60	50	30（双芯）	150	-55~150
2DK12B		70	60			
2DK12C		80	70			
^a 当 T_{C} 超过 75°C 时,按 $40\text{mA}/^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。						

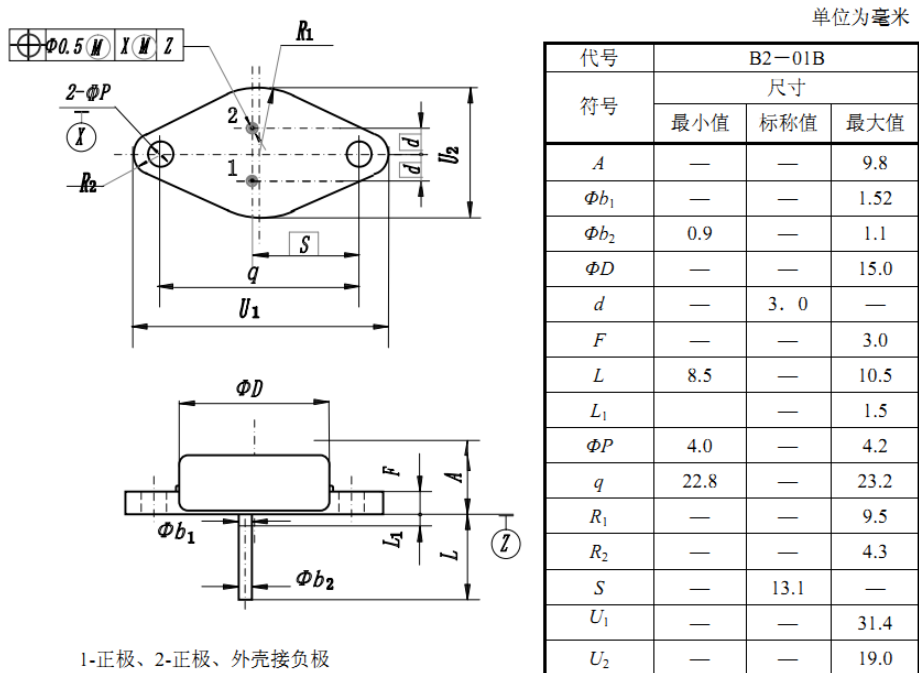
4、主要电特性

主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

特性	符号	条件	最大值	单位
反向电流	I_{R1}	$V_R=0.8V_{RWM}$	1.0	mA
正向电压	V_{FM1}	$I_{FM}=3\text{A}$	0.65	V
总电容	C_{tot}	$f=1\text{MHz}, V_R=5.0\text{V}$	2000	pF
热阻	$R_{th(j-c)}$	加热电流 $I_{F1}=1\text{A}\sim 5\text{A}$	9.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

5、外形尺寸



B2-01B 外形尺寸

6、使用和维护

6.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

6.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严格禁止超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。